# BEST AVAILABLE COPY

# MAGNETIC RECORDING MEDIUM, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND MAGNETIC RECORDING DEVICE

Patent number:

JP2003296925

Publication date:

2003-10-17

Inventor:

DAVID JAYAPURAWIRA; DOMON HIROKI;

YOSHIMURA SATORU; TAKAHASHI KEN

**Applicant:** 

TAKAHASHI KEN; ANELVA CORP; FUJI ELECTRIC

CO LTD; ULVAC CORP; SHOWA DENKO KK

Classification:

- international:

G11B5/66; G11B5/851; G11B5/66; G11B5/84; (IPC1-7):

G11B5/84; G11B5/64; G11B5/66; G11B5/673;

G11B5/738

- european:

G11B5/66; G11B5/851

**Application number:** JP20020096582 20020329 **Priority number(s):** JP20020096582 20020329

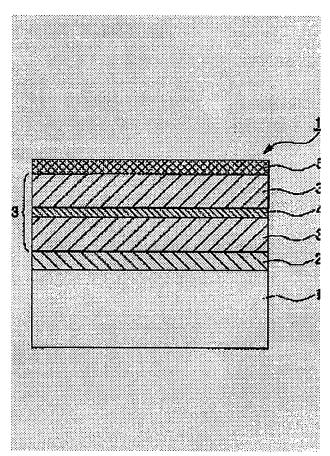
Report a data error he

Also published as:

WO03083843 (A1) US2005214584 (A

#### Abstract of JP2003296925

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a magnetic recording medium having a flat surface, a high shift magnetic field and excellent thermal stability. SOLUTION: The method for manufacturing the magnetic recording medium 10 includes successive laminating of a nonmagnetic substrate 1, a metallic ground surface layer 2 and ferromagnetic metallic layers 3, in which the process step of depositing the layers 3 is formed as a process step of alternately laminating a plurality of ferromagnetic films 3a and 3b and one or more nonmagnetic metallic spacer layers 4 and includes a process step of physically adsorbing oxygen and/or nitrogen on at least the boundary of the spacer layers 4. COPYRIGHT: (C)2004, JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19) 日本国特許庁(JP)

#### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-296925 (P2003-296925A)

(43)公開日 平成15年10月17日(2003.10.17)

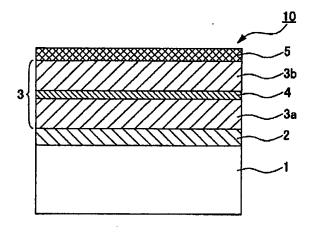
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(51) Int.CL7		識別記号	ΡI		テーマコート*(参考)
G11B	5/84		G11B	5/84	Z 5D006
	5/64			5/64	5D112
	5/66			5/66	
	5/673			5/673	
	5/738			5/738	
			水脑查審	未請求 請求項(	の数14 OL (全 12 頁)
(21) 出願番号		特顧2002-98582(P2002-96582)	(71)出願人	. 592259129	
				高橋 研	
(22) 出顧日		平成14年3月29日(2002.3.29)	ļ	宫城県仙台市太田	<b>自区人来田 2 丁目20 - 2</b>
			(71)出顧人	. 000227294	
				アネルパ株式会社	±
				東京都府中市四名	学5丁目8番1号
			(71)出顧人	. 000005234	
				當士電機株式会社	±.
				神奈川県川崎市ノ	川崎区田辺新田1番1号
			(74)上記4	名の代理人 10007	
				弁理士 山口	殿 (外2名)
					最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 磁気記録媒体、その製造方法および磁気記録装置

#### (57)【要約】

【課題】 表面が平坦であって、高いシフト磁界を有するとともに、熱的な安定性に優れる磁気記録媒体を製造する方法を提供する。

【解決手段】 本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、非磁性基体1と、金属下地層2と、強磁性金属層3 とを順に積層して含む磁気記録媒体10の製造方法であって、前記強磁性金属層3を成膜する工程が、複数の強磁性膜3a、3bと、一以上の非磁性金属スペーサ層4を交互に積層する工程とされ、前記非磁性金属スペーサ層4の少なくとも界面に、酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させる工程を含むことを特徴としている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基体と、金属下地層と、強磁性金-属層とを順に積層してなる磁気記録媒体の製造方法であって、

前記強磁性金属層を成膜する工程が、複数の強磁性膜 と、一以上の非磁性金属スペーサ層とを交互に積層する 工程とされ。

前記非磁性金属スペーサ層の少なくとも界面に、酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させる工程を含むことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【間求項2】 前記酸素及び/又は窒素が、非磁性金属スペーサの膜中に含まれるように前記非磁性金属スペーサ層を成膜することを特徴とする間求項1に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項3】 前記非磁性金属スペーサ層の成膜に用いるガスが、Ar又はそれ以外の希ガスに、酸素または窒素を混合してなる混合ガスであることを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項4】 前記混合ガスに含まれる酸素又は窒素の 分圧を、10<sup>-7</sup>Torr以上10<sup>-3</sup>Torr以下とする 20 ことを特徴とする請求項3に記載の磁気記録媒体の製造 方法。

【請求項5】 前記混合ガスに含まれる酸素又は窒素の 分圧を、3×10-°Torr以上3×10-°Torr以 下とすることを特徴とする請求項4に記載の磁気記録媒 体の製造方法。

【請求項6】 前記非磁性金属スペーサ層の少なくとも 界面に、酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させる工程 が、酸素及び/又は窒素を含む雰囲気に、前記非磁性金 属スペーサ層の表面を曝露する工程であることを特徴と 30 する請求項1ないし5のいずれか1項に記載の磁気記録 媒体の製造方法。

【 請求項7 】 前記非磁性金属スペーサ層表面の酸素暴露量を、10ラングミュア以上とすることを特徴とする 請求項6 に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項8】 前記非磁性金属スペーサ層として、R u、Ir、Cu、Osから選ばれる1種以上の元素を含む金属膜を成膜することを特徴とする請求項1ないし7 のいずれか1項に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項9】 前記非磁性金属スペーサ層の膜厚を、 0.5nm以上1.0nm以下とすることを特徴とする 請求項1ないし8のいずれか1項に記載の磁気記録媒体 の製造方法。

【請求項10】 非磁性基体と、金属下地層と、強磁性金属層とを順に積層して含む磁気記録媒体であって、前記強磁性金属層が、複数の強磁性膜と、酸強磁性膜の間に形成された非磁性金属スペーサ層とを含み、前記強磁性金属層のシフト磁界H<sub>ex</sub>が、10000e以

【請求項11】 前記強磁性金属層のシフト磁界H

上とされたととを特徴とする磁気配録媒体。

。xが、15000e以上とされたことを特徴とする請求 項10に記載の磁気記録媒体。

【請求項12】 非磁性基体と、金属下地層と、強磁性金属層とを順に積層して含む磁気記録媒体であって、前記強磁性金属層が、複数の強磁性膜と、該強磁性膜の間に形成された非磁性金属スペーサ層とを含み、前記非磁性金属スペーサ層が、Ru, Ir, Cu, Osから選ばれる1種以上の元素を含む金属膜からなり、少なくとも前記非磁性スペーサ層と前記強磁性膜との界10 面に、酸素及び/又は窒素が物理的に吸着されていると

【請求項13】 前記非磁性金属スペーサ層の膜厚が、 0.5 n m以上1.0 n m以下とされたことを特徴とす る請求項10ないし12のいずれか1項に記載の磁気記 録媒体。

【請求項14】 請求項10ないし13のいずれか1項 に記載の磁気記録媒体と、該磁気記録媒体を駆動するための駆動部と、磁気情報の記録再生を行うための磁気へッドとを備え、移動する前記磁気記録媒体に対して前記 磁気ヘッドにより磁気情報の記録再生を行うことを特徴とする磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

とを特徴とする磁気配録媒体。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録媒体、その製造方法および磁気記録装置に係り、より詳細には、高いシフト磁界を有する積層フェリ磁気記録媒体およびその製造方法と、この磁気記録媒体を備えた磁気記録装置に関するもので、本発明に係る磁気記録媒体は、ハードディスク、磁気テーブなどに好適に用いられる。

0 [0002]

【従来の技術】近年、磁気記録媒体は、高密度で大容量な記録媒体としてハードディスク装置等で多用されているが、更なる高密度化を図るためにその記録再生特性の向上と磁化経時変化の低減の両立が求められている。図11と図12は、磁気記録媒体の一例であるハードディスクを示す概略図である。図11は、円盤型の磁気記録媒体の斜視図であり、図12は図11に示すA-A線に沿う模式断面図である。図11に示す磁気記録媒体90は、図12に示すように円盤型の非磁性体からなる基体4091と、この基体91上に形成された金属下地層93と強磁性金属層95と保護層96とを備えて構成されている。

【0003】との例の磁気記録媒体90では、非磁性体からなる基体91として例えばA1合金またはガラスからなる基板92の表面上にNi-Pからなる非磁性層93を設けてなるものが用いられている。そして、との基体91の上には、例えばCrからなる金属下地層94,CoCrTaあるいはCoCrTaPtなどからなる磁性膜の強磁性金属層95、カーボンなどからなる保護層5096が順次積層されている。典型的な各層の厚さは、非

3

磁性 (Ni-P) 層93が5μm~15μm、金属(Cr)下地層94が50nm~150nm、強磁性金属層-95が30nm~100nm、保護層96が20nm~50nmである。尚、保護層96上には、図示されないが、パーフルオロポリエーテルなどのフッ素系の潤滑剤などが被覆されるとともある。

【0004】上記構成の磁気記録媒体において記録再生特性を向上させるためには、強磁性金属層95として機能する磁性膜を構成する磁性結晶粒子の粒間相互作用の低減、並びに磁性膜の膜厚の低減が必要不可欠であると 10とが、本発明者らにより報告されている。(M.Takahashi, A.Kikuchi and S.Kawakita:IEEE Trans. On Magn., 33. 2938(1997))

特に、媒体の低ノイズ化を図るためには、強磁性金属層 95をなす膜厚を低減することにより、磁性膜を構成す る磁性結晶粒子を微細化させることが有効な手法の一つ として同文献に紹介されている。

【0005】強磁性金属層95をなす磁性膜の薄膜化による、微細組織形成や、磁性粒子の体積低減には限界がある。なぜならば、強磁性金属層95をなす磁性膜の膜20厚の低減に伴い、磁性膜を構成する結晶粒子は微細化し、磁性膜に記録された磁化(残留磁化)等の磁気特性が経時的に大きく変化してしまうという問題、すなわち熱擾乱の影響を受けやすくなるという問題が生じるためである。

【0006】そとで、磁気記録媒体の熱擾乱を抑制するために、二層以上の強磁性金属層間に厚さが0.7nm程度の非磁性金属中間層(Ru)を挿入することによって、残留磁化において最隣接強磁性層の磁化が反平行状態になる、いわゆる積層フェリ磁気記録媒体が考案される。(E.N.Abarrra, A. Inomata, H. Sato, I. Okamoto, and Y. Mizoshita:Appl. Phys. Lett., 77, 2581(2000))

このような積層フェリ媒体においては、強磁性層間に非磁性スペーサ層を挿入することで発生するシフト磁界により、磁気記録媒体の経時変化を抑制できることが有効な手法の一つとして同文献に紹介されている。

【0007】しかしながら、高記録密度化に伴い磁気記録媒体に記録される磁化パターンはさらに小型化すると考えられており、これに対応するため、シフト磁界の向 40上が求められている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、表面が平坦であって、高いシフト磁界を有するとともに、熱的な安定性に優れる磁気配録媒体を製造する方法を提供することを目的の1つとする。本発明は、上述の優れた特性を有する磁気記録媒体を備える磁気記録装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、非磁性基体と、金属下地層と、強磁性金属層とを順に積層してなる磁気記録媒体の製造方法であって、前記強磁性金属層を成膜する工程が、複数の強磁性膜と、一以上の非磁性金属スペーサ層とを交互に積層する工程とされ、前記非磁性金属スペーサ層の少なくとも界面に、酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させる工程を含むことを特徴としている。上記製造方法によれば、強磁性金属層が、非磁性金属スペーサ層により複数の強磁性膜に分割された積層フェリ磁気記録媒体におけるシフト磁界を高めることができ、優れた熱的安定性を有する磁気記録媒体を容易に製造することができる。

【0010】また、上記本発明に係る磁気記録媒体の製造方法においては、前記酸素及び/又は窒素が、非磁性金属スペーサの膜中に含まれるように前記非磁性金属スペーサ層を成膜することもできる。

【0011】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、前記非磁性金属スペーサ層の成膜に用いるガスが、Ar又はそれ以外の希ガスに、酸素または窒素を混合してなる混合ガスであることを特徴とする。上記製造方法によれば、容易に非磁性金属スペーサ層と強磁性膜との界面に酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させることができ、かつそれらの吸着量を精度良く制御することができるので、熱的な安定性に優れる磁気記録媒体を、安定に製造することが可能である。

【0012】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、前記混合ガスに含まれる酸素または窒素の分圧を、10-7Torr以上10-3Torr以下の範囲とすることを特徴とする。混合ガス中の酸素又は窒素の分圧を上記範囲とすることで、熱的安定性に優れるとともに、優れた磁気特性を有する磁気記録媒体を製造することができる。前記分圧が10-7Torr(=133×10-7Pa)未満の場合には、H。が小さくなる傾向にあり、10-3Torr(=133×10-3Pa)を越える場合には、保磁力H。が低減する傾向にあるため、高H。よ、高Hcを両立し得る範囲として上述の分圧範囲とした。

【0013】また、上記製造方法においては、前記混合ガスに含まれる酸素又は窒素の分圧を、3×10-3Torr以下とすることがより好ましい。係る範囲に酸素分圧を設定することで、15000以上の高いシフト磁界H<sub>ex</sub>を得ることができ、優れた熱的安定性を得ることができる。

【0014】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、前記非磁性金属スペーサ層の少なくとも界面に、酸素及び/又は窒素を物理的に吸着させる工程が、酸素及び/又は窒素を含む雰囲気に、前記非磁性金属スペーサ層の表面を曝露する工程であることを特徴とする。上50 記製造方法によっても、上記非磁性金属スペーサ層と強

20

磁性膜との界面に、容易に酸素及び/又は窒素を物理的 に吸着させることができる。

- 【0015】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方 法においては、前記非磁性金属スペーサ層表面の酸素暴 露量を、10ラングミュア以上とすることが好ましい。 上記非磁性金属スペーサ層表面の酸素曝露量を上記範囲 とすることで、熱的安定性に優れる磁気記録媒体を製造 することができる。この酸素曝露量が10ラングミュア 未満の場合には、熱的安定性を向上させる効果を十分に 得られない。

【0016】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方 法においては、前記非磁性金属スペーサ層として、R u、Ir、Cu、Osから選ばれる1種以上の元素を含 む金属膜を成膜することが好ましい。上記元素を含む合 金により非磁性金属スペーサ層を構成することで、強磁 性膜のシフト磁界を増大させることができ、もって媒体 の熱的安定性を大きく向上させることができる。

【0017】次に、本発明に係る磁気記録媒体の製造方 法においては、前記非磁性金属スペーサ層の膜厚を、

0.5 n m以上1.0 n m以下とすることが好ましい。 【0018】次に、本発明は、上配課題を解決するため に、非磁性基体と、金属下地層と、強磁性金属層とを順 に積層してなる磁気記録媒体であって、前記強磁性金属 層が、複数の強磁性膜と、該強磁性膜の間に形成された 非磁性金属スペーサ層とを含み、前記強磁性金属層のシ フト磁界H。xが、10000e以上とされたことを特徴 とする磁気記録媒体を提供する。上記構成によれば、非 磁性金属スペーサ層により分離された強磁性膜間に作用 する高いシフト磁界Hexにより熱的安定性に優れた磁気 記録媒体を実現することができる。さらに、本発明に係 30 る磁気記録媒体は、前記シフト磁界Hagを15000e 以上とすることもでき、より熱的安定性に優れた磁気記 録媒体を提供することができる。

【0019】次に、本発明に係る磁気記録媒体は、非磁 性基体と、金属下地層と、強磁性金属層とを順に積層し て含む磁気記録媒体であって、前記強磁性金属層が、複 数の強磁性膜と、該強磁性膜の間に形成された非磁性金 属スペーサ層とを含み、前記非磁性金属スペーサ層が、 Ru, Ir, Cu, Osから選ばれる1種以上の元素を 含む金属膜からなり、少なくとも前記非磁性スペーサ層 40 と前記強磁性膜との界面に、酸素及び/又は窒素が物理 的に吸着されていることを特徴としている。

【0020】次に、本発明に係る磁気記録媒体において は、前記非磁性金属スペーサ層の膜厚が、0.5nm以 上1.0 n m以下とされることが好ましい。

【0021】本発明に係る磁気配録装置は、先に記載の 磁気記録媒体と、該磁気記録媒体を駆動するための駆動 部と、磁気情報の記録再生を行うための磁気ヘッドとを 備え、移動する前記磁気記録媒体に対して前記磁気へっ ドにより磁気情報の記録再生を行うことを特徴とする。

上記構成の磁気記録装置によれば、高速回転するスピン ドルや制御チップ等の発熱により加熱された状態で長時 間使用しても磁気特性に劣化を生じることのない、優れ た信頼性を有する磁気記録装置を提供することができ る。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を参照して説明する。図1及び図2は本発明に係る磁気 記録媒体をコンピュータのハードディスクに適用した一 10 実施形態の断面構造を模式的に示すもので、図1に示す 磁気記録媒体10は、円盤状の非磁性体からなる基体1 上に、金属下地層2を介して、強磁性金属層3と、保護 層5とを積層してなる構造とされている。そして、前記 強磁性金属層3は、金属下地層2側から、第1の強磁性 膜3a、非磁性金属スペーサ層4、第2の強磁性膜3b を順に積層した構造とされている。この種の構造を有す る磁気記録媒体は、一般に、積層フェリ磁気記録媒体と 呼ばれている。また、図1 に示す本実施形態の磁気配録 媒体10の積層構造は、本発明に係る磁気記録媒体の最 も基本的な構造であるので、基体1と第1の強磁性膜3 aとの間に他の中間層を必要に応じて設けた構成として も良く、図2に示す磁気記録媒体20のように、図1に 示す磁気記録媒体10と同様の基本構造を有し、強磁性 金属層3が、第1の強磁性膜3 a と、非磁性金属スペー サ層4aと、第2強磁性膜3bと、非磁性金属スペーサ 層4bと、第3強磁性膜3cとを順に積層した構成とし ても良い。すなわち、強磁性金属層3の構造は、複数の 強磁性膜と、複数の非磁性金属スペーサ層とが交互に積 層された構造とされていれば、その積層数に構成上の制 限はない。また、保護層5の上にフッ素系の潤滑剤から なる潤滑層を設けても良いのは勿論である。

【0023】以下、図1を参照して本発明に係る磁気記 録媒体の基本構成を備えた磁気記録媒体10をさらに詳 細に説明する。

(基体) 本発明に係る基体 1 としては、例えば、アルミ ニウムとその合金あるいは酸化物、チタンとその合金或 いは酸化物、またはシリコン、ガラス、カーボン、セラ ミック、プラスチック、樹脂およびそれらの複合体化か らなる基板の表面に、異種材質の非磁性層をスパッタ 法、蒸着法、メッキ法等の成膜法により、表面コーティ ング処理を行ったものを例示することができる。この場 合に基体 1 の表面部に設けられた非磁性層は、高温で磁 化せず、導電性を有し、機械加工などが施しやすい反 面、適度な表面硬度を有していることが好ましい。この ような条件を満たす非磁性材料の膜としては、特にメッ キ法により作製されたNi-P膜が好ましい。

【0024】基体1の形状としては、ディスク用途の場 合、ドーナツ円盤状のものが使われる。後述する強磁性 金属層等を設けた基体、すなわち磁気記録媒体は、磁気 50 記録および再生時、円盤の中心を軸として、例えば36

(5)

00rpm~15000rpmの速度で回転させて使用 される。このとき、磁気記録媒体の表面又は裏面の上空 - を磁気ヘッドが0. 1 μm程度の高さ、あるいは数10 nmの高さを持って浮上走行する。また、さらに低浮上 量の10 n m以下の高さで浮上走行する磁気ヘッドの開 発もなされている。従って、基体1としては表面又は裏 面の平坦性、表裏両面の平行性、基体円周方向のうね り、および表裏面の粗さが適切に制御されたものが望ま しい。

【0025】また、基体が回転/停止する場合には、磁 10 気記録媒体と磁気ヘッドの表面同士が接触、摺動するよ うになっている (Contact Start Stop:CSS)。この対策 として、基体の表面には、略同心円状の軽微なキズ(テ クスチャ)をダイヤモンドやアルミナなどの砥粒を含む スラリーやテープによる研磨により形成して磁気ヘッド 接触時の吸着を防止する場合もある。

【0026】上記テクスチャについては、図12に示す 従来構造の如くNi-Pの非磁性層93の上面にて研磨 テープを摺動させてキズをつけることでV字溝型に形成 することが一般的になされているので、本実施形態の構 20 造においてもNi-P等からなる非磁性層1bの表面に テクスチャを形成しても良い。また、上記ヘッド摺動特 性改善を目的としたテクスチャに代わるものとして、レ ーザ加工によるテクスチャや、スパッタリングによる離 散的な凹凸膜テクスチャ、保護膜のエッチングによる凹 凸型のテクスチャなどを形成した構造も知られているの でとれらの構造を採用し、非磁性層1bの上面に所望の 形状の凹凸等を形成しても良いことはもちろんである。 さらにまた、最近では磁気へッドを磁気記録媒体にロー ド/アンロードする方式で磁気記録媒体の停止中に磁気 30 ヘッドを磁気記録媒体の外側に待機させるものも登場し ている。このような方式を採用するならば、場合によっ てはテクスチャを省略する構成も可能である。

【0027】また、上記テクスチャは、強磁性金属層の 面内方向に磁気情報を記録する方式では特に重要な役割 を担っており、基体1表面に略同心円状のテクスチャを 形成することにより、基体1上に形成される金属下地層 2の配向面を変化させ、結果として金属下地層2上に形 成される強磁性金属層3の結晶粒を基体円周方向に配向 させることができる。このテクスチャ処理による磁性結 晶粒の配向制御は、記録再生時の磁気記録媒体の磁気特 性や記録再生特性に大きく影響するので、磁性結晶粒の 配向制御を目的とするテクスチャは、形成する溝の密度 や、溝の深さの均一性を適切に制御することが好まし 64.

【0028】(金属下地層)本実施形態の磁気記録媒体 10の金属下地層2は、スパッタ法や蒸着法などにより 順次積層形成した多層構造をなすものである。との金属 下地層2の格子定数を制御することにより、金属下地層

**とかできる。また、上記金属下地層2は、2層または** 3層以上の下地膜を積層した構成としてもよい。上記金 属下地層2 にはCr およびCr 合金を用いることが好ま しい。合金とする場合には、例えば、Mo、W、Ti、 V、Nb、Ta等との組み合わせが用いられ、特に、C r M o 合金、C r W 合金を用いることが好ましい。金属 下地層2としてCrあるいはCr合金を用いることによ り、金属下地層2上に形成される強磁性金属層3に対し て偏析作用を起とさせることができる。この偏析作用に より強磁性金属層3の結晶粒界に生じる高Cr 濃度相に よって強磁性金属層3の結晶粒間の磁気的な相互作用を 抑えることができるので、媒体の規格化保磁力を高める ととができる。また、金属下地層2上の強磁性金属層3 の磁化容易軸(c軸)が基体面内方向を取るようにする ことができる、すなわち、基体面内方向の保磁力を高め る方向に強磁性金属層3の結晶成長を促すものである。 【0029】また、基体1としてガラス基板を用いる場 合には、Ni-AlあるいはNi-Nbなどのシード層 を金属下地層2と基体1との間に設けることが好まし い。このような構成とするならば、金属下地層2や強磁 性金属層3の結晶粒が微細化されるので、磁気記録媒体 の保磁力を高めることができるとともに、記録再生時の ノイズ特性を向上させることができる。

【0030】CrやCr合金からなる金属下地層2をス パッタ法で成膜する場合、その結晶性を制御する因子と しては、基体の表面形状(テクスチャの有無など)、表 面状態、表面温度、成膜時の圧力、基体に印加するバイ アス、および形成する膜厚等が挙げられる。後述する強 磁性金属層3の保磁力は金属下地層であるCr膜やCr 合金膜の膜厚にほぼ比例して高くなる傾向にあるが、膜 厚の増加に伴って成膜面の表面粗さも増大する傾向にな る。しかしながら、磁気配録媒体の記録密度を向上させ るためには、磁気ヘッドの磁気記録媒体表面からの浮上 量をできる限り小さくすることが求められる。従って、 金属下地層2の膜厚が薄くても高い保磁力が得られるよ うな材料を用いて金属下地層2は構成されることが望ま

【0031】(強磁性金属層)本発明で用いられる強磁 性金属層3を構成する強磁性膜3aと3bはhcp構造 を有する強磁性金属材料からなる層である。これらの強 磁性膜3aと強磁性膜3bの膜厚は次の関係式になるよ うに調整する。

 $B_r t_t = B_r t_b - B_r t_a$ 

てこで、B, t, は媒体トータル(所望)の残留磁束密 度、B,t。は強磁性金属層3bの残留磁束密度、B,t。 は強磁性金属層3aの残留磁束密度であり、上記B.t. は、通常、上記磁気記録媒体と組み合わせて用いる磁気 ヘッドの記録再生能力に応じて決定される。強磁性金属 層3aと3bを構成する材料としては、Coを主成分と 2上に形成される強磁性金属層3の保磁力を向上させる 50 するCo基強磁性合金を用いることが好ましい。その具 体的な材料としては、例えばCoNiCr、CoCrT a, CoPt, CoCrPt, CoNiPt, CoNi .CrTa, CoCrPtTa等を挙げることができる。 また、Cれらの合金にB、N、O、Nb、Zr、Cu、 Ge, Si等から選ばれる1種又は2種以上の元素を添 加した合金を用いることもできる。尚、強磁性金属層3 aの上または強磁性金属層3bの下にlnm程度の膜厚 でCoを積層しても良い。

【0032】(非磁性金属スペーサ層)図3は、本発明 に係る磁気記録媒体の磁化曲線の一例であり、図4は、 本発明に係る磁気記録媒体10におけるシフト磁界H. の導出方法を説明するための説明図である。積層フェリ 媒体においては、図1に示す強磁性膜3aと強磁性膜3 bの間に非磁性金属スペーサ層4を挟むことにより両者 の間にRKKY交換相互作用J。xが生じ、とのJ。xの存 在により、強磁性膜3aに内部磁界が生じる。この内部 磁界の向きは強磁性膜3bの磁化の向きと逆方向であ る。そのため、強磁性膜3aの保磁力が内部磁界よりも 小さく、かつ、外部磁界が存在しない場合、強磁性膜3 aと3bの磁化が反平行状態となる。従って、外部磁界 が十分に大きい状態(図3のグラフの両端側)において は、強磁性膜3a、3bの磁化の向きはいずれも外部磁 界の向きと同一方向となるが、外部磁界が0の状態で は、強磁性膜3 aの磁化の向きと、強磁性膜3 bの磁化 の向きが逆向きになる。 ととで、上記強磁性膜3 a に掛 かる内部磁界をシフト磁界H。xと呼ぶことにする。この シフト磁界Hexは、図4に示すように、ある方向に媒体 を飽和させた後その磁界を取り除き、そして逆方向の磁 界を印加した際に、強磁性膜3 a の磁化曲線が原点から シフトする量として導出することができる。本発明に係 30 いて以下に詳細に説明する。 る磁気記録媒体においては、強磁性膜3aにかかる内部 磁界であるシフト磁界H。xは、1000(Oe)以上と することが好ましく、このような範囲とすることで、保 磁力2000~40000eの媒体における熱的安定性 を向上させることができ、信頼性に優れる磁気記録媒体 とすることができる。より詳細には、上記保磁力の媒体 においてKuV/k。Tを80~90以上とすることが できる。また、シフト磁界H。まを15000e以上とす るならば、KuV/k<sub>B</sub>Tを100以上とすることがで きる。とのシフト磁界H。この上限は、特に限定されない 40 が、上述の保磁力の磁気配録媒体においては、2500 Oeを越えるシフト磁界を得るのは困難である。非磁性 金属スペーサ層4を構成する材料としては、Ru、I Γ、Cu、Osから選ばれる1種以上の元素を含む合金 であることが好ましい。これらの材料を非磁性金属スペ ーサ層4として用いることで、シフト磁界Hexを向上さ せることができる。また、本発明に係る非磁性金属スペ ーサ層4は、少なくともその界面に酸素及び/又は窒素 が物理的に吸着されている。これらのガスを吸着させる ととで、本発明に係る磁気記録媒体10は、図4に示す 50 【0036】あるいは、非磁性金属スペーサ層4の成膜

ように、より高いシフト磁界H.xを実現することがで き、より熱的安定性に優れる磁気記録媒体とされてい る。非磁性金属スペーサ層4は膜厚が0.5nm以上 1. 0 n m以下の範囲であることが好ましい。この範囲 において、シフト磁界H。xが最大を示すためである。 【0033】以下に、上記の構成の磁気記録媒体10を スパッタ法により製造する場合について説明する。

10

(スパッタ法) 本発明に係る磁気記録媒体10を製造す る方法の一例であるスパッタ法として、例えば、基体1 10 がターゲットの前を移動しながら薄膜が形成される搬送 型スパッタ法と、基体1をターゲットの前に固定して薄 膜が形成される静止型スパッタ法を例示することができ る。前者の搬送型スパッタ法は、量産性が高いため、低 コストな磁気記録媒体の製造に有利であり、後者の静止 型スパッタ法は、基体1に対するスパッタ粒子の入射角 度が安定なために、記録再生特性に優れる磁気記録媒体 の製造が可能とされる。本発明に係る磁気記録媒体10 を製造する際には、搬送型、静止型のいずれかに限定さ れるものではない。

【0034】本発明に係る磁気記録媒体10は、上述の スパッタ法により、基体1上に順次金属下地層2、強磁 性金属層3(強磁性膜3a、非磁性金属スペーサ層4、 強磁性膜3 b)、及び保護膜5を成膜することで製造す ることができる。そして、本発明に係る製造方法により 磁気配録媒体10を製造する場合、非磁性金属スペーサ 層4の成膜中又は成膜後に、酸素及び/又は窒素を含む 雰囲気中に基体1を配置し、少なくとも非磁性金属スペ ーサ層4と強磁性膜3a、3bとの界面に酸素及び/又 は窒素を物理的に吸着させる処理を行う。この処理につ

【0035】非磁性金属スペーサ層4と、第2の強磁性 膜3bとの界面のみに酸素及び/又は窒素を物理的に吸 着させるには、非磁性金属スペーサ層4を成膜後、酸素 および/または窒素を含む雰囲気に非磁性金属スペーサ 層4の表面を曝露することで表面に所定量の酸素や窒素 を吸着させることができる。この曝露処理では、酸素や 窒素の分圧、および曝露時間により非磁性金属スペーサ 層4表面への吸着量を制御することが可能である。先に 記載の材料により非磁性金属スペーサ層4を構成する場 合には10L (ラングミュア: Langmuir) 以上とすると とが好ましい。ここで、1Lとは、1×10-°Torr で1秒間曝露するか、1×10-7Torrで10秒間曝 露することを意味し、25Lとは1×10-°Torrで 25秒間曝露するか、1×10<sup>-7</sup>Torrで250秒間 曝露することを意味する。尚、実際の製造における酸素 や窒素の分圧、曝露時間は、非磁性金属スペーサ層4を 構成する材料の酸素との親和力に応じて適宜最適な圧力 や時間に設定すればよい。また、酸素や窒素を希ガスで 希釈したガスを用いてもよい。

(7)

に用いるガスとして、Ar又はこれ以外の希ガスに、酸 素及び/又は窒素を添加した混合ガスを用いて成膜する . ととにより、非磁性金属スペーサ層4の表面に酸素や窒 素からなるガス成分を物理的に吸着させることができ る。との方法では、非磁性金属スペーサ層4の内部にも 酸素や窒素が取り込まれるために、過剰な酸素、窒素添 加を行うと非磁性金属スペーサ層4を構成する材料によ っては結晶性の低下や、酸化物、窒化物の生成が起こる 場合がある。従って、酸素や窒素の添加量は、Arまた は希ガスとの混合ガスにおける分圧で、10-7 Torr 以上10-7 Torr以下の範囲とすることが好ましい。 さらに、前記混合ガスに含まれる酸素又は窒素の分圧 は、3×10-6Torr以上3×10-3Torr以下と することが好ましい。係る範囲とすることで、1500 Oe以上のシフト磁界を得ることができ、KuV/k。 Tを100以上とすることができる。

11

【0037】本発明における「成膜に用いるArガスの 不純物」としては、例えば、H<sub>2</sub>O、O<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、 N<sub>z</sub>、C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>、H、C、O、CO等が挙げられる。特 に、膜中に取り込まれる酸素量に影響する不純物は、H 20 2O、O2、CO2、O、COと推定される。従って、本 発明の不純物濃度は、成膜に用いるArガス中に含まれ ているH2O、O2、CO2、O、COの和で表すととと する。

【0038】また、基体1へのバイアス印加は、磁気配 録媒体の保磁力を増大させる効果を奏する。この効果 は、一層のみのパイアス印加よりも、二層又はそれ以上 の層の成膜時にも印加した場合の方がより大きくなる傾 向がある。

【0039】(媒体の表面粗さ、Ra) 本発明における 30 基体の表面粗さとしては、例えば、ディスク形状からな\*

\* る基体表面を、半径方向に測定した場合の、平均中心線 粗さRaが挙げられる。表面粗さRaの測定器として は、原子間力顕微鏡(AFM)を用いることができる。 本発明に係る磁気記録媒体においては、シフト磁界H. と媒体の非磁性金属スペーサ層4または媒体の表面組さ Raとの間には相関関係がある。非磁性金属スペーサ層 4の表面粗さRaが低いほど、シフト磁界H...を大きく することができる。これは、非磁性金属スペーサ層の界 面粗さは、orange peel効果と呼ばれているNeelのモデ 10 ルにより、強磁性層界面に磁極を発生し、磁性層磁化を 平行にそろえようとする、強磁性的な静磁気結合をもた らすことが知られている(L. Neel:Comp. Rend. Acad. Sci., 255, 1545 (1962))。図5に、Neelモデルを 説明するための説明図であり、強磁性金属層3の断面機 造を模式的に示す図である。この図に示すように、下地 層2上に形成された強磁性金属層3は、下地層2表面の 凹凸形状に沿った形状に形成されている。さらに、磁性 層厚を有限の厚さに拡張したKoolsらのモデル(). C. S. Kools, W. Kula, D. Mauri and T. Lin: J. App 1. Phys., 85, 4466 (1999)) を適用し、[数1]を用 いて強磁性層間に働く強磁性的結合エネルギーJfを計 算したものを図6に示す。ととで、膜は積層数が29の 多層膜構造であり、強磁性層と非磁性金属スペーサ層の 膜厚は1nmと仮定した。図6から明らかなように、強 磁性的結合エネルギーJfの大きさは結晶粒径Lと界面 粗さhに依存している。従って、結晶粒径が同等であれ ば、界面粗さの減少は、磁性層間の強磁性的結合エネル ギーJfを低減させ、磁性層間の反強磁性的結合エネル ギーJ。xを増大させ、シフト磁界H。xの増大に繋がる。

[0040] 【数1】

 $J_f(erg/cm^2) = 2\frac{\pi^2}{\sqrt{2}} \frac{h^2}{L} M^2 \exp\left(-2\pi\sqrt{2} \frac{d_{ev}}{L}\right) \left(1 - \exp\left(-2\pi\sqrt{2} \frac{d_{Cv}}{L}\right)\right)^2$ 

【0041】但し、上記(数1)において、d.。及びd c。はそれぞれ非磁性金属スペーサ層4及び強磁性膜3 a (3b)の膜厚を示している。

【0042】さらに、基体1が停止状態から回転を開始 した場合、或いはその逆に回転状態から停止状態になっ および摺動する(CSS動作)。このとき、磁気ヘッド の媒体表面への吸着や摩擦係数の上昇を抑えるため、表 面粗さRaは大きい方が好ましい。一方、基体が最大回 転数に達した場合には、磁気配録媒体と磁気ヘッドの間 隔、すなわち磁気ヘッドの浮上量をできるだけ小さい値 に確保する必要があるので、Raは小さい方が好まし い。従って、基体1の表面粗さRaの最大値と最小値 は、上述した理由と、磁気記録媒体による要求スペック から適宜決定される。

 $ch(約0.6 \mu m)$ の場合は、 $Ra=6nm\sim8nm$ であ る。しかし、さらに高記録密度化を図るためには、磁気 ヘッドの浮上量(記録再生動作をする際、磁気ヘッドが 磁気記録媒体から離れている距離)をより小さくする必 要がある。この要望に応えるためには、磁気記録媒体の た場合は、磁気記録媒体と磁気ヘッドの表面同士が接触 40 表面をより平坦化することが大切となる。このような理 由から基体の表面粗さRaは、より小さなものが望まし い。従って、基体の表面粗さがより小さな場合であって も、目標とする各種の膜特性を得られる作成方法を適宜 採用すればよい。一例としてA1基板上にNi-P層を 設けた構造の場合にテクスチャを設けた上でRaを1. 5 n m以下にまで低減することがなされており、特別な 研磨処理を施したNiP/Al基板でのRaを0.5n m~0.7nmとすることもできる。

【0044】(テクスチャ処理)本発明における基体に 【0043】例えば、磁気ヘッドの浮上量が、24 µ in 50 施すテクスチャ処理としては、例えば、機械的な研磨に (8)

よる方法、科学的なエッチングによる方法、物理的な凹凸膜の付与による方法などが挙げられる。特に、磁気記録体の基体として最も広く用いられているアルミニウム合金基体の場合には、機械的な研磨による方法が採用されている。例えば、アルミニウム合金基体の表面に設けた(Ni-P)膜に対して、研削用の砥粒が表面に接着してあるテーブを、回転する基体表面に押しつけるととにより、同心円状に軽微なキズを付与する方法がある。との方法では、研削用の砥粒を、テーブから遊離させて用いる場合もある。しかし、上記「基体の表面粗さ」の項で述べた理由から、上記テクスチャ処理を行わないか、若しくはより軽微なテクスチャ形状でも、目標とする各種の膜特性を得られる作成方法を適宜採用すればよい。

13

[0045]

【実施例】以下に試験例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの試験例に限定されるものではない。

【0046】(試験例1)本試験例では、図1に示す非磁性金属スペーサ層4を備える磁気記録媒体成膜時の酸 20素(O₁)ガス分圧を10⁻¹Torr~10⁻¹¹Torrの範囲で変化させて作製した。成膜法として直流マグネトロン法を用い、成膜室の到達真空度を10⁻゚Torr台、ブロセスガス中の不純物濃度を1ppb以下とした超清浄ブロセスを用いて成膜を行った。その際、基体温度は放射加熱ヒータを用いて250℃とし、基体加熱後、Arガス圧2~5mTorrとして上記金属下地層、強磁性金属層、非磁性スペーサ層と保護層を成膜した。非磁性スペーサ層の成膜には、Arガスとともに酸素(O₂)ガスも微量に混ぜて行った。また、金属下地 30層および強磁性金属層の成膜時に基体へのバイアス印加 およびドライエッチングは行わなかった。

【0047】本試験例では、基体として、表面を超平滑 研磨(Ra<0.3nm)され、テクスチャ処理されて いないディスク状のNiPメッキA1基板を用い、下地 膜形成用のターゲットとしてCrMozoターゲットを用 い、第1と第2強磁性膜形成用のターゲットとしてCo - 1 6 at%Cr - 8 at%Pt - 4 at%Bターゲットを用 いた。非磁性スペーサ層形成用のターゲットとしてRu ターゲットを用いた。また、各層の膜厚は、下地膜5n m、第1強磁性膜2.5nm、第2強磁性膜9nm、非 磁性金属スペーサ層0.8nm、保護膜6nmとした。 【0048】次に、上記にて得られた磁気配録媒体につ いて、揺らぎ場H、(Oe)及び耐熱擾乱性の指標であ るKuV/k。Tの測定を行った。その結果を図7及び 図8に示す。図7及び図8に示すように、本発明に係る 製造方法により製造された磁気記録媒体は、いずれも8 O以上のKuV/k。Tを有しており、熱的安定性に優 れた磁気記録媒体であることが確認された。また非磁性

らぎ場Hfは低減され、KuV/k.Tは増加してお り、より詳細には、非磁性金属スペーサ層4の成膜時の 酸素分圧を10-7Torrとした試料(H..≒1100 Oe) に比して、酸素分圧を10-1Torrとした試料 (H. . ≒20000e) では、揺らぎ場が約30%低減 され、KuV/k。Tは約22%増加している。また図 7に示すように、酸素分圧を3×10-プTorr~3× 10-1Torrの範囲とした場合に、100以上のKu V/k。Tが得られており、特に熱的安定性に優れた磁 10 気記録媒体が得られることが確認された。そして、上記 100以上のKuV/k。Tが得られる範囲では、強磁 性膜のH。。は15000e以上の高い値を示した。この ように本発明に係る製造方法によれば、非磁性金属スペ ーサ層4の成膜時の酸素分圧を適切な範囲に設定すると とにより、さらに優れた熱的安定性を有する磁気記録媒 体を製造できる。

【0049】尚、本試験例では金属下地層、強磁性金属層の成膜法として直流マグネトロンスパッタ法を用いたが、RFスパッタ法、レーザ蒸着法、イオンビーム成膜などの他の成膜法を実施しても良いのはもちろんである。

【0050】(磁気記録装置)次に、本発明に係る磁気記録装置を図面を参照して以下に説明する。図9は、本発明に係る磁気記録装置であるハードディスク装置の一例を示す側断面図であり、図10は、図9に示す磁気記録層の平断面図である。図8および図9において、50は磁気へッド、70はハードディスク装置、71は筐体、72は磁気記録媒体、73はスペーサ、79はスイングアーム、78はサスペンションである。本実施形態に係るハードディスク装置70は、先に記載の本発明の磁気記録媒体を搭載している。

【0051】ハードディスク装置70は、円盤状の磁気 記録媒体72や、磁気ヘッド50などを収納する内部空間を備えた直方体形状の筺体71が外径を成しており、この筺体71の内部には複数枚の磁気記録媒体72がスペーサ73と交互にスピンドル74に押通されて設けられている。また、筺体71にはスピンドル74の軸受け(図示せず)が設けられ、筺体71の外部にはスピンドル74を回転させるためのモータ75が配設されている。この構成により、全ての磁気記録媒体72は、スペーサ73によって磁気ヘッド50が入るための間隔を空けて複数枚重ねた状態で、スピンドル74の周回りに回転自在とされている。

いて、揺らぎ場H、(Oe)及び耐熱擾乱性の指標であるKuV/k。Tの測定を行った。その結果を図7及び の側方位置には、軸受け76によってスピンドル74と 図8に示す。図7及び図8に示すように、本発明に係る 製造方法により製造された磁気記録媒体は、いずれも8 回転軸77が配置されている。この回転軸77には複数 の以上のKuV/k。Tを有しており、熱的安定性に優 個のスイングアーム79が各磁気記録媒体72の間の空れた磁気記録媒体であることが確認された。また非磁性 間に延出するように取り付けられている。各スイングア 金属スペーサ層4の成膜時の酸素分圧を高くするほど揺 50 ーム79の先端には、その上下位置にある各磁気記録媒

(9)

体72の表面と傾斜して向かう方向に固定された、細長 い三角板状のサスペンション78を介して磁気ヘッド5 0が取り付けられている。との磁気ヘッド50は、図示 されていないが、磁気記録媒体72に対して情報を書き 込むための記録素子と、磁気記録媒体72から情報を読 み出すための再生素子を備えるものである。

【0053】上記構成によれば、磁気記録媒体72を回 転させ、磁気ヘッド50をスイングアーム79の移動に より磁気記録媒体72の半径方向に移動させることがで きるので、磁気ヘッド50は磁気記録媒体72上の任意 10 録媒体の断面構成図である。 の位置に移動可能となっている。上述した構成のハード ディスク装置70では、磁気記録媒体72を回転させる とともに、スイングアーム79を移動させて磁気ヘッド 50を磁気記録媒体72を構成している強磁性金属層に 磁気ヘッド50が発生した磁界を作用させることにより 磁気記録媒体72に所望の磁気情報を書き込むことがで きる。また、スイングアーム79を移動させて磁気へっ ド50を磁気記録媒体72上の任意の位置に移動させ、 磁気記録媒体72を構成している強磁性金属層からの漏 気情報を読み出すことができる。

【0054】とのように磁気情報の読み出しと書き込み を行う場合において、磁気記録媒体72の強磁性金属層 が、先に説明した如く優れた規格化保磁力と熱安定性を 有しているならば、ハードディスク装置70の内部がモ ータ75の熱を受けて、例えば、100℃を越える高い 温度に加熱されつつ使用された場合であっても、磁気記 録媒体72の強磁性金属層が劣化するととがない。ま た、長期間使用し、長時間加熱されることがあっても、 ドディスク装置70を提供することができる。

【0055】尚、図9、10を基に先に説明したハード ディスク装置70は、磁気記録装置の一例を示すもので あるので、磁気記録装置に搭載する磁気記録媒体の枚数 は、1枚以上の任意の枚数で良く、搭載する磁気ヘッド の数も1個以上であれば任意の数設けてもよい。また、 スイングアーム79の形状や駆動方式も図面に示すもの に限らず、リニア駆動方式、その他の方式でも良いのは もちろんである。

[0056]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に よれば、磁気記録媒体のHexを向上することにより、高 い記録再生特性S/N比と優れた熱安定性を有する磁気 記録媒体を得ることができる。

【0057】また、前記優れた磁気特性を有する磁気記 録媒体を備えた磁気記録装置であるならば、加熱状態で 長時間使用しても磁気特性に劣化を生じることのない磁 気記録装置を提供することができる。また、先の優れた 磁気特性を有する磁気記録媒体を備えた磁気記録装置で あるならば、S/N比が高く、記録再生特性に優れた磁 気配録装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明の一実施の形態である磁気記

【図2】 図2は、本発明に係る磁気記録媒体の他の構 成例を示す断面構成図である。

【図3】 図3は、本発明に係る磁気記録媒体の磁化曲 線の一例を示す図である。

【図4】 図4は、シフト磁界H。の導出方法を説明す るための説明図である。

【図5】 図5は、本実施形態の磁気記録媒体の強磁性 金属層を拡大して示す説明図である。

図6は、図5に示す平均結晶粒径しと界面粗 【図6】 れ磁界を磁気ヘッドの再生素子で検出することにより磁 20 さんが強磁性的相互作用 J f に与える影響を示すグラフ である。

> 【図7】 図7は、本発明の実施例における揺らぎ場H fの測定結果を示すグラフである。

【図8】 図8は、本発明の実施例におけるKuV/k Tの測定結果を示すグラフである。

【図9】 図9は、本発明に係る磁気記録装置の断面構 成図である。

【図10】 図10は、図9に示す磁気記録装置の一部 断面を含む平面構成図である。

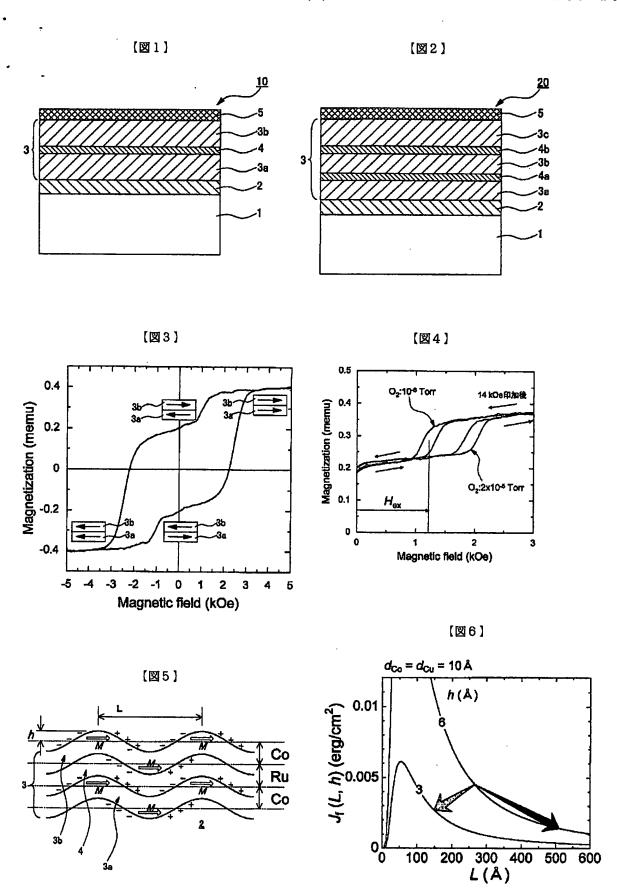
磁気記録媒体72の記録再生特性に劣化を生じないハー 30 【図11】 図11は、磁気記録媒体の一例を示す斜視 図である。

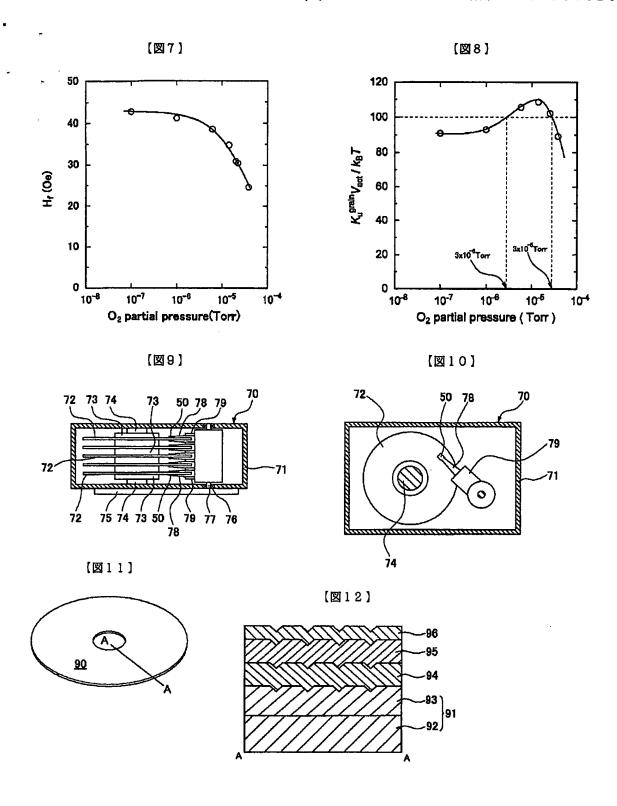
> 【図12】 図12は、図11に示す磁気記録媒体の断 面構造を示す図である。

【符号の説明】

10、20 磁気記録媒体

- 1 非磁性基体
- 2 金属下地層
- 3 強磁性金属層
- 3a 第1の強磁性膜
- 40 3b 第2の強磁性膜
  - 3 c 第3の強磁性膜
  - 4、4a、4b 非磁性金属スペーサ層
  - 5 保護膜





フロントページの続き

(71)出願人 000231464株式会社アルバック神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

(71)出願人 000002004 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門 1 丁目13番9号 (74)上記1名の代理人 100075166

弁理士 山口 巖

- (72)発明者 ダビッド ジャヤブラウィラ

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉05 東北大

学大学院工学研究科電子工学専攻内

(72)発明者 土門 宏紀

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉05 東北大

学大学院工学研究科電子工学専攻内

(72)発明者 吉村 哲

官城県仙台市青葉区荒巻字青葉05 東北大

学大学院工学研究科電子工学専攻内

(72)発明者 髙橋 研

宫城県仙台市太白区人来田2丁目20-2

Fターム(参考) 50006 BB01 BB07 BB08 CA01 CA05

EA03 FA09

5D112 AA03 AA05 AA06 AA24 BB01

BD03 BD07 FA04 GA25

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
FADED TEXT OR DRAWING				
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
GRAY SCALE DOCUMENTS				
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
□ other:				

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.